

١٤١١٤



دانشگاه صنعتی
بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی برق - مخابرات (گرایش میدان)

عنوان:

طراحی، بهینه سازی و ساخت آنتن مايكرواستريپ با پهنه ای باند زياد



استاد راهنما:

دکتر محمد حسن نشاطی
پروفسور جلیل راشد محصل

استاد مشاور:

دکتر سید سعید توکلی
۱۳۸۷ / ۹ / ۲۳

تحقیق و نگارش:

ناصر قاسمی

(این پایان نامه از حمایت مالی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و

بلوچستان بهره مند شده است)

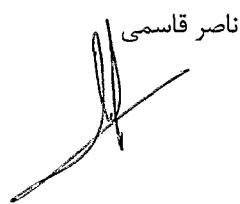
مهر ۱۳۸۷

۱۴۲۱۱۴

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان طراحی، بهینه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپ با پهنهای باند زیاد، قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق توسط دانشجو ناصر قاسمی تحت راهنمایی استاد پایان نامه دکتر محمد حسن نشاطی و پروفسور جلیل راشد محصل تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد.

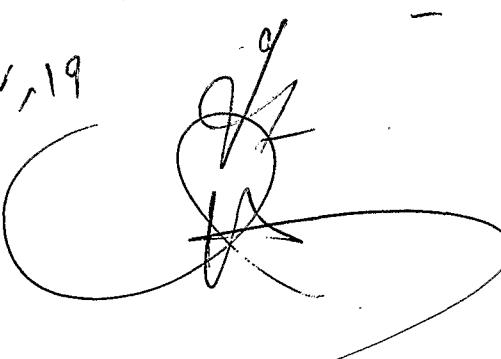
ناصر قاسمی



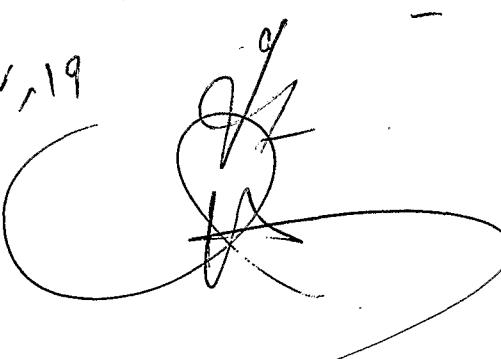
این پایان نامه ۱۹ توسط هیئت داوران بررسی و درجه ۶ به آن تعلق گرفت.

نام و نام خانوادگی	استاد راهنما:
دکتر محمد حسن نشاطی	استاد راهنما:
پروفسور جلیل راشد محصل	استاد راهنما:
دکتر سید سعید توکلی	استاد مشاور:
دکتر شهرام مهناز	داور ۱:
دکتر عطاری	داور ۲:
دکتر سروری	نماینده تحصیلات تكمیلی:

۸/۷/۱۹



۸/۷/۱۹





دانشگاه سیستان و بلوچستان

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب ناصر قاسمی تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو؛ ناصر قاسمی

امضاء

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم که همه وجودم فدای یک لبخند آنهاست.

سپاسگزاری

صمیمانه ترین مراتب سپاس خود را به محضر استاد گرانقدر و عزیزم، پروفسور راشد محلل که با محبت و صبر و حوصله فراوان در تمام مراحل این پروژه مرا راهنمایی و یاری نمودند، تقدیم می‌نمایم. افتخار شاگردی در محضر ایشان موهبت بزرگی بود که خداوند نصیب اینجانب کرد. از خداوند متعال برای ایشان سلامتی و جزای خیر آرزو دارم و امیدوارم که این مرز و بوم همواره سعادت بهره مندی از ایشان را داشته باشد. بر خود لازم می‌دانم از زحمات استاد عزیزم جناب آقای دکتر مرادی که همواره مشوق، راهنمای و الگوی علمی و اخلاقی من بودند صمیمانه تشکر کنم.

همچنین از سرکارخانم دکتر فرحتناز مهنا و جناب آقای دکتر شهرام مهنا که امکانات بسیاری را در اختیار بnde قرار دادند و به من اعتماد کردند، تشکر کنم.

از جناب آقای مهندس یاشار زرهفروش که عنوان پایان نامه را به من پیشنهاد کردند و در تمامی مراحل همواره از راهنمایی‌های ارزشمند ایشان استفاده کرده‌ام تشکر می‌کنم. همچنین از کمک‌های شایان جناب آقای مهندس خسروی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکر می‌کنم.

در پایان لازم می‌دانم از زحمات جناب آقای دکتر طریفکار، مهندس صمیمی و دکتر کریمی که در دوره کارشناسی افتخار شاگردی این عزیزان را داشتم، تشکر کنم.

چکیده:

آنتن‌های میکرواستریپ در سالهای اخیر به صورت گستردگی در مخابرات و سیستم‌های رادار استفاده شده‌اند. مهم‌ترین مزایای این نوع آنتن‌ها عبارتند از: وزن کم، قیمت ارزان، ابعاد کوچک و قابل استفاده و ساخت همزمان با مدارهای چاپی است. آنتن‌های میکرواستریپ دارای دو عیب اساسی پهنهای باند کم و بهره پایین نیز می‌باشند. برای افزایش پهنهای باند و بهره این آنتن‌ها روش‌های مختلفی مانند استفاده از عایق‌های با ثابت دی‌الکتریک پایین، به کار بردن پیچ‌های اضافی در کنار پیچ اصلی، استفاده از ساختارهای چند لایه شامل فاصله هوایی بین لایه‌ها معرفی شده است.

در این پایان نامه چندین ساختار جدید پهنه باند با گین زیاد که برای اولین بار معرفی، محاسبه، شبیه‌سازی و تعدادی از آنها ساخته شدند ارائه می‌شود. این آنتن‌ها دارای ساختار چندلایه و شامل چند رزناتور با فرکانس‌های تشحیض نزدیک بهم می‌باشند.

اولین ساختار چند لایه، آنتن مایکرواستریپی تغذیه شده با کابل هم محور است که دارای سه پیچ مستطیلی در لایه پایینی و یک پیچ دیگر در لایه بالایی است. نتایج اندازه‌گیری نشان می‌دهد که پهنهای باند آنتن ۹ GHz و ۶ GHz (%) و بهره آن در طول پهنهای باند حداقل dB ۸ است.

آنتن دیگری که از دو پیچ رویهم تشکیل و از طریق روزنہ مستطیلی روی سطح زمین تغذیه شده است در محدوده فرکانسی GHz ۵/۹ تا ۱۶ GHz کار می‌کند. پهنهای باند شبیه سازی شده آن تا ۴۴٪ و گین آنتن حداقل dB ۸ در پهنهای باند GHz ۱/۵ (۴۰٪) است. ضخامت آنتن طرح شده ۰/۱۴۸ است که کمترین ضخامت در ساختارهای چند لایه می‌باشد.

ساختار جدیدی دیگری که با دو روزنہ روی سطح زمین و با تغذیه خط مایکرواستریپ U شکل طراحی شده است و نتایج شبیه سازی و آزمایشی آن ارائه شده، دارای پهنهای باند حدود ۷۰٪ (۵/۱۰ GHz تا ۲۲ GHz) و با گین حداقل dB ۷ در پهنهای باند ۴۷٪ می‌باشد. نتایج شبیه سازی و اندازه‌گیری این آنتن‌ها مطابقت خوبی دارند.

کلمات کلیدی: آنتن‌های مایکرواستریپ – پهنهای باند زیاد

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱.....	فصل اول: مقدمه
۲.....	مقدمه
۳.....	-۱- معرفی آنتن های مایکرواستریپ
۴.....	-۲-۱ مزایا و معایب آنتن های مایکرواستریپ
۵.....	-۲-۲ ساختار پایان نامه
۶.....	فصل دوم: آنتن های مایکرواستریپ
۷.....	-۱-۲ کاربردهای آنتن های مایکرواستریپ
۸.....	-۲-۲ روشهای تغذیه آنتن های مایکرواستریپ
۹.....	-۳-۲ روشهای تحلیلی آنتن های مایکرواستریپ
۱۰.....	-۴-۲ نرم افزارهای شبیه سازی
۱۱.....	فصل سوم: روشهای افزایش پهنای باند و بهره آنتن های مایکرواستریپ
۱۲.....	مقدمه
۱۳.....	-۱-۳ انتخاب ابعاد مناسب برای پچ ها و محل مناسب تغذیه
۱۴.....	الف) تأثیر محل تغذیه
۱۵.....	ب) انتخاب ابعاد مناسب برای پچ
۱۶.....	-۲-۳ استفاده از عایق با ضخامت زیاد
۱۷.....	استفاده از لایه هوا و عایق با ضریب دی الکتریک پایین
۱۸.....	-۳-۳ ایجاد شکاف بر روی پچ
۱۹.....	-۴-۳ استفاده از پچ های اضافی در کنار پچ اصلی
۲۰.....	-۵-۳ استفاده از ساختارهای چند لایه
۲۱.....	تأثیر طول پچ مربعی بالایی بر روی امپدانس ورودی آنتن
۲۲.....	تأثیر طول پچ مربعی پایینی بر روی امپدانس ورودی آنتن
۲۳.....	تأثیر فاصله هوایی بین دو پچ بر مشخصات آنتن

۲۹	تأثیر قرار نگرفتن دقیق پچ‌ها رویهم	
۳۲	فصل چهارم: بررسی آنتن‌های میکرواستریپ پهن‌باند	
۳۳	مقدمه	
۳۳	- آنتن میکرواستریپ مستطیلی	
۳۶	- آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل غیر متقارن بر روی پچ	
۳۹	- آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل متقارن	
۴۲	- آنتن میکرواستریپ با پچ E شکل	
۴۴	- آنتن میکرواستریپ با پچ‌های اضافی U شکل	
۴۵	- آنتن مایکرواستریپ تغذیه شده با شکاف H شکل	
۴۸	- آنتن میکرواستریپ با دو پچ رویهم	
۵۰	- آنتن میکرواستریپ چند لایه با تغذیه روزنه‌ای	
۵۳	- آنتن میکرواستریپ با شکاف Π شکل بر روی صفحه زمین	
۵۶	فصل پنجم: طراحی و ساخت آنتن میکرواستریپ چند لایه پهن‌باند با تغذیه کابل هم محور	
۵۷	مقدمه	
۵۷	- ساختار شماره ۱: آنتن مایکرواستریپ دو لایه با تغذیه کابل هم محور	
۵۹	- نتایج شبیه‌سازی تاثیر پچ‌های اضافی بر مشخصات آنتن با ساختار ۱	
۶۰	- نتایج شبیه‌سازی تاثیر محل تغذیه بر مشخصات آنتن با ساختار ۱	
۶۱	- تأثیر فاصله بین پچ اصلی با پچ‌های اضافی بر مشخصات آنتن با ساختار ۱	
۶۵	- محدودیت‌های ساخت آنتن ساختار ۱	
۶۷	اثر شعاع داخلی کانکتور SMA بر مشخصات آنتن	
۶۸	- ساخت آنتن	
۷۱	فصل ششم: طراحی و ساخت آنتن‌های میکرواستریپ چند لایه پهن‌باند با تغذیه روزنه‌ای	
۷۲	مقدمه	
۷۲	- ساختار شماره ۲: آنتن مایکرواستریپ چند لایه با دو پچ رویهم	
۷۳	بررسی پارامتری و نتایج شبیه‌سازی آنتن با ساختار ۲	
۷۳	(الف) تأثیر ضخامت عایق D_h	
۷۴	(ب) تأثیر ابعاد روزنه و نتایج شبیه‌سازی	
۷۵	(ج) تأثیر محل روزنه نسبت به خط تغذیه	
۷۵	(د) نتایج شبیه‌سازی تأثیر تغییر محل پچ‌ها در جهت افقی	

ساختار شماره ۲ : آنتن نهایی.....	۷۶
ساختار شماره ۲ : ساخت آنتن و نتایج اندازه‌گیری.....	۷۶
۲-۶ - ساختار شماره ۳ : آنتن مایکرواستریپ با تغذیه U شکل نامتقارن تک روزنه	۷۷
نتایج شبیه سازی آنتن با ساختار ۳.....	۷۸
۳-۶ - ساختار شماره ۴ : آنتن مایکرواستریپ با تغذیه U شکل نامتقارن با دو روزنه	۷۹
ساخت آنتن و نتایج اندازه‌گیری	۸۰
۴-۶ - ساختار شماره ۵ : طراحی آنتن مایکرواستریپ چند لایه در باند S و C.....	۸۲
نتایج شبیه سازی ساختار شماره ۵.....	۸۳
۵-۶ - ساختار شماره ۶ : طراحی آنتن مایکرواستریپ چند لایه در باند X و C	۸۷
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات	۹۳
مراجع	۹۷

فهرست جدول ها

عنوان جدول	صفحه
جدول ۱-۳ مقادیر پهنهای باند و گین آنتن شکل (۳-۱) برای مقادیر مختلف W	۱۳
جدول ۲-۳ بررسی تاثیر عایق با ضریب دیالکتریکهای مختلف	۱۵
جدول ۳-۳ تأثیر ضخامت پوشش بر روی پهنهای باند و فرکانس تشدید آنتن	۱۸
جدول ۴-۳ تأثیر ضریب دیالکتریک عایق پوشش دهنده بر روی پهنهای باند و فرکانس تشدید و پهنهای باند آنتن.	۱۸
جدول ۵-۳ تأثیر ضخامت فاصله هوایی بر روی گین و پهنهای باند آنتن مایکرواستریپ مربعی	۲۹
جدول ۱-۵ ابعاد آنتن ساختار شماره ۱	۵۸
جدول ۲-۵ پهنهای باند و گین آنتن برای هشت محل مختلف تغذیه	۶۱
جدول ۳-۵ پهنهای باند و گین آنتن برای هشت محل مختلف تغذیه	۶۲
جدول ۱-۶ مشخصات عایق های مایکرواستریپ چند لایه با دو پیچ رو بهم ساختار ۲	۷۳
جدول ۲-۶ مشخصات آنتن مایکرواستریپ چند لایه با تغذیه U شکل نامتقاضن	۷۷
جدول ۳-۶ مشخصات کامل آنتن با ساختار ۴ در شکل ۹-۶	۸۰
جدول ۳-۶ ابعاد نهایی آنتن در فرکانس های باند C و S	۸۵
جدول ۲-۶ ابعاد نهایی آنتن ساختار ۶	۹۰

فهرست شکل ها

صفحه	عنوان شکل
۳	شکل ۱-۱ ساختار آنتن مایکرواستریپ
۳	شکل ۲-۱ شکل های مختلف پج آنتن مایکرواستریپ
۷	شکل ۲-۲ تغذیه به روش استفاده از کابل هم محور
۷	شکل ۲-۳ تغذیه با استفاده از اتصال مستقیم خط مایکرواستریپ
۸	شکل ۳-۱ تغذیه به روش تزویج الکترومناظلیسی
۸	شکل ۴-۱ تغذیه با استفاده از شکاف روی صفحه زمین
۱۱	شکل ۴-۲ تغذیه با استفاده از فوکانی و جانبی آنتن مایکرواستریپ مستطیلی تغذیه با کابل هم محور
۱۲	شکل ۴-۳ نمودار امپدانس ورودی برای سه محل تغذیه متفاوت
۱۳	شکل ۴-۴ نمودار امپدانس ورودی برای چهار W متفاوت
۱۵	شکل ۴-۵ نمودار $VSWR$ و امپدانس ورودی برای دو مقدار مختلف ضخامت دی الکتریک
۱۶	شکل ۵-۱ آنتن دارای پوشش (الف) ساختار آنتن، (ب) تاثیر ضخامت پوشش روی آنتن، (ج) تاثیر ضریب دی الکتریک پوشش روی آنتن.
۱۹	شکل ۶-۱ آنتن مایکرواستریپ با دو شکاف روی پج
۱۹	شکل ۶-۲ نمودار تلفات برگشتی آنتن شکل ۶-۱
۲۰	شکل ۸-۱ آنتن مایکرواستریپ با پج اضافی: (الف) ساختار آنتن، (ب) نمودار اسمیت امپدانس ورودی، (ج) نمودار $VSWR$
۲۱	شکل ۹-۱ (الف) امپدانس ورودی، (ب) نمودار $VSWR$ برای دو نقطه تغذیه مختلف
۲۲	شکل ۱۰-۱ (الف) امپدانس ورودی، (ب) نمودار آنتن مایکرواستریپ مستطیلی با پج

اضافی

- ۲۲ شکل ۱۱-۳ الف) امپدانس ورودی ، ب) نمودار $VSWR$ آنتن مایکرواستریپ با پج اضافی
بر حسب فاصله پجها
- ۲۳ شکل ۱۲-۳ نمودار تشعشع آنتن مایکرواستریپ با پج اضافی در فرکانس‌های مختلف (الف)
 $2/9\text{ GHz}$ ، 3 GHz ، $2/9\text{ GHz}$ ، ب)
- ۲۴ شکل ۱۳-۳ آنتن مایکرواستریپ با تزویج الکترومغناطیسی
- ۲۴ شکل ۱۴-۳ آنتن مایکرواستریپ با تزویج الکترومغناطیسی
- ۲۵ شکل ۱۵-۳ آنتن مایکرواستریپ مربعی با ۲ پج رویهم : الف) نمای بالایی ، ب) نمای جانبی
- ۲۶ شکل ۱۶-۳ الف) امپدانس ورودی، ب) نمودار $VSWR$ آنتن با دو پج مربعی برای چهار
مقدار طول پج بالایی
- ۲۶ شکل ۱۷-۳ نمودار تشعشعی آنتن مایکرواستریپ با دو پج مربعی رویهم در فرکانس GHz
 $3/7$
- ۲۷ شکل ۱۸-۳ نمودار امپدانس ورودی و $VSWR$ آنتن با دو پج مربعی رویهم
- ۲۸ شکل ۱۹-۳ نمودار امپدانس ورودی و $VSWR$ آنتنی با طول پج بالایی و پایینی $25mm$
و تغذیه به فاصله 11 cm
- ۳۰ شکل ۲۰-۳ الف) امپدانس ورودی، ب) $VSWR$ آنتن مایکرواستریپ مربعی دو لایه با
تغییر مکان پج بالایی در جهت‌های x و y
- ۳۱ شکل ۲۱-۳ الف) امپدانس ورودی، ب) نمودار $VSWR$ آنتن مایکرواستریپ با پج مربعی
برای سه مقدار ضخامت لایه هوایی
- ۳۳ شکل ۱-۴ نمای بالایی و جانبی آنتن مایکرواستریپ
- ۳۴ شکل ۲-۴ نمودار امپدانس ورودی آنتن برای سه حالت مختلف
- ۳۴ شکل ۳-۴ نمودار گین سه آنتن با مشخصات جدول ۱-۴
- ۳۵ شکل ۴-۴ نمودار تشعشع آنتن در صفحه $E(x,z)$ و در صفحه $H(y,z)$ در فرکانس‌های 1844 MHz و 1900 MHz
- ۳۶ شکل ۵-۴ نمودار امپدانس ورودی آنتن با عایقی با ثابت دیالکتریک ۳ و نمودار امپدانس

ورودی آنتن بدون استفاده از شکاف بروی پچ آن

۳۶	شکل ۴-۶ نمودار بهره آنتن با عایقی با ثابت دیالکتریک ۳
۳۷	شکل ۷-۴ ساختار آنتن با شکاف
۳۷	شکل ۸-۴ نمودار امپدانس ورودی آنتن به ازای ۵ مقدار طول بازوی کوچکتر شکاف
۳۸	شکل ۹-۴ نمودار گین آنتن به ازای ۵ مقدار طول بازوی کوچکتر شکاف
۳۸	شکل ۱۰-۴ نمودار امپدانس ورودی شبیه سازی شده و اندازه گیری شده آنتن
۳۸	شکل ۱۱-۴ نمودار بهره شبیه سازی شده و اندازه گیری شده آنتن
۳۹	شکل ۱۲-۴ (الف) نمودار تشعشعی شبیه سازی شده ، (ب) نمودار اندازه گیری شده
۴۰	شکل ۱۳-۴ آنتن میکرواستریپ با شکاف L شکل متقارن
۴۰	شکل ۱۴-۴ تصویر ساخته شده آنتن
۴۱	شکل ۱۵-۴ تأثیر ضخامت لایه هوایی را بر روی امپدانس ورودی آنتن
۴۱	شکل ۱۶-۴ (الف) نمودار امپدانس ورودی ، (ب) نمودار بهره آنتن
۴۲	شکل ۱۷-۴ نمودار تشعشعی آنتن در سه فرکانس مختلف
۴۲	شکل ۱۸-۴ آنتن مایکرواستریپ با پچ E شکل
۴۳	شکل ۱۹-۴ تأثیر عوامل مختلف بر روی نمودار امپدانس ورودی آنتن
۴۴	شکل ۲۰-۴ نمودار اندازه گیری شده و شبیه سازی شده امپدانس ورودی آنتن
۴۴	شکل ۲۱-۴ نمودار بهره آنتن در فرکانس‌های مختلف
۴۵	شکل ۲۲-۴ آنتن مایکرواستریپ با پچ های اضافی L شکل
۴۵	شکل ۲۳-۴ نمودار امپدانس ورودی آنتن
۴۶	شکل ۲۴-۴ آنتن مایکرواستریپ تغذیه شده به وسیله شکاف H شکل
۴۷	شکل ۲۷-۴ نمودار بهره آنتن را در چهار حالت مختلف برای دیالکتریکی بین پچ و صفحه زمین
۴۷	شکل ۲۸-۴ تصویر آنتن ساخته شده
۴۷	شکل ۲۹-۴ نمودار شبیه سازی شده و اندازه گیری شده امپدانس ورودی آنتن
۴۸	شکل ۳۰-۴ نمودار تشعشعی آنتن در دو فرکانس (الف) ۱۰۳۰ MHz و (ب) ۱۰۹۰ MHz

- شکل ۴-۳۱ ساختار آنتن مایکرواسترپ با دو پج رویهم ۴۸
- شکل ۴-۳۲ (الف) نمودار امپدانس ورودی با پج پایینی، (ب) نمودار امپدانس ورودی آنتن با دو پج رویهم ۴۹
- شکل ۴-۳۳ (الف) تاثیر طول پج بالایی بر امپدانس ورودی آنتن به ازاء مقادیر مختلف طول، (ب) تاثیر عرض پج بالایی بر امپدانس ورودی ۴۹
- شکل ۴-۳۴ آنتن با پج مستطیلی با تنظیمه روزنهای ۵۰
- شکل ۴-۳۵ نمای فوقانی آنتن و ابعاد آن ۵۱
- شکل ۴-۳۶ آنتن ساخته شده در داخل قاب ۵۱
- شکل ۴-۳۷ نمودار امپدانس ورودی شبیه سازی شده و اندازه گیری شده آنتن ۵۲
- شکل ۴-۳۸ نمودار امپدانس ورودی شبیه سازی شده و اندازه گیری شده آنتن ۵۲
- شکل ۴-۳۹ نمودار تشعشعی آنتن را در صفحه (الف) E و (ب) H ۵۲
- شکل ۴-۴۰ نمودار تشعشعی آنتن را در صفحه (الف) E و (ب) H پس از قرار دادن صفحه فلزی پشت آنتن ۵۳
- شکل ۴-۴۱ آنتن میکرواستریپ با شکاف II شکل II شکل و موقعیت آن نسبت به خط ۵۴
- شکل ۴-۴۲ ابعاد پج و شکاف U شکل و ابعاد شکاف تغذیه ۵۴
- شکل ۴-۴۳ نمودار امپدانس ورودی آنتن میکرواستریپ ۵۵
- شکل ۴-۴۴ نمودار بھره آنتن میکرواستریپ ۵۵
- شکل ۴-۴۵ نمودار تشعشع آنتن میکرواستریپ ۵۵
- شکل ۵-۱ ساختار آنتن شماره ۱ : (الف) نمای فوقانی، (ب) نمای جانبی ۵۸
- شکل ۵-۲ نمودارهای شبیه سازی شده: (الف) $VSWR$ ، (ب) گین آنتن ساختار ۱ در شرایط مختلف ۶۰
- شکل ۵-۳ معرفی پارامتر های نمودار امپدانس ورودی ۶۰
- شکل ۵-۴ تأثیر محل تغذیه آنتن بر نمودار تشعشع آنتن ساختار ۱ در فرکانس ۱۵ GHz (الف) $x, y=3, 1, 0, 5$ (ب) $x, y=3, 0, 5, 0$ ۶۱
- شکل ۵-۵ نتایج شبیه سازی نمودار تشعشع آنتن ساختار ۱ برای ۴ مقدار مختلف ۶۲

- شکل ۵-۶ نمودار گین آنتن در زاویه صفر درجه ۶۳
- شکل ۷-۵ نمودار اسمیت امپدانس ورودی ۶۳
- شکل ۸-۵ نتایج شبیه سازی میدانهای راه دور و نزدیک و تشعشع سه بعدی آنتن ساختار ۶۴
- شکل ۹-۵ نمودار تشعشع آنتن در فرکانس‌های ۶۴
- شکل ۱۰-۵ ساختار جدید برای آنتن ۶۶
- شکل ۱۱-۵ VSWR و گین آنتن منحنی ۱ مربوط به پچ تنها، منحنی ۲ مربوط به یک پچ تغذیه شده و دو پچ کناری، منحنی ۳ مربوط به سه پچ با پچ اضافی در لایه بالایی ۶۷
- شکل ۱۲-۵ نمودار VSWR آنتن به ازاء شعاع هادی داخلی کابل تغذیه (۱) $0.0/4 \text{ mm}$ و (۲) $0.0/5 \text{ mm}$ و (۳) $0.0/635 \text{ mm}$ ۶۷
- شکل ۱۳-۵ ساختار نهایی آنتن مایکرواستریپ چند لایه ۶۸
- شکل ۱۴-۵ تأثیر اضافه کردن فاصله هوایی بین پچ تغذیه شده و پچ اصلی ۶۸
- شکل ۱۵-۵ تصویر آنتن ساخته شده (الف) نمای بالایی، (ب) نمای جانبی ۶۹
- شکل ۱۶-۵ نمودار VSWR و بهره اندازه گیری شده و شبیه سازی شده ۷۰
- شکل ۱۷-۵ نمودار تشعشعی اندازه گیری شده آنتن در 14 GHz ۷۰
- شکل ۱۸-۶ نمای بالایی و جانبی آنتن مایکرواستریپ چند لایه با دو پچ رویهم ساختار ۲ ۷۳
- شکل ۱۹-۶ نتایج شبیه سازی و تأثیر ضخامت عایق D بر VSWR ۷۴
- شکل ۲۰-۶ نتایج شبیه سازی اثر طول روزنه بر VSWR، منحنی ۱: $L_2 = 8 \text{ mm}$ و منحنی ۲: $L_2 = 7 \text{ mm}$ و منحنی ۳: $L_2 = 7.5 \text{ mm}$ ۷۴
- شکل ۲۱-۶ نتایج شبیه سازی VSWR بر حسب محل روزنه نسبت به خط تغذیه، منحنی ۱: $L = 2 \text{ mm}$ و منحنی ۲: $L = 2.5 \text{ mm}$ و منحنی ۳: $L = 3 \text{ mm}$ ۷۵
- شکل ۲۲-۶ تأثیر تغییر محل پچ‌ها در راستای افقی ۷۵
- شکل ۲۳-۶ آنتن نهایی ساختار شماره ۲ ۷۶
- شکل ۲۴-۶ آنتن مایکرواستریپ چند لایه با تغذیه U شکل نامتقارن ۷۷
- شکل ۲۵-۶ نمودار VSWR و گین آنتن با تغذیه U شکل غیر متقارن ۷۸

- شکل ۹-۶ آنتن با تغذیه U شکل نامتقارن و با دو روزنه روی سطح زمین
- شکل ۱۰-۶ نمودار $VSWR$ و گین آنتن ساختار ۴ با تغذیه U شکل نامتقارن و با دو روزنه
- شکل ۱۱-۶ تصویر آنتن ساخته شده ساختار شماره چهار (الف) نمای بالا، ب) نمای خط تغذیه
- شکل ۱۲-۶ نتایج شبیه سازی و اندازه گیری شده $VSWR$ و گین آنتن با تغذیه U شکل نامتقارن با دو روزنه
- شکل ۱۳-۶ نمای سه بعدی و نمای بالای و کنار ساختار آنتن برای فرکانس‌های باند S و C
- شکل ۱۴-۶ نتایج شبیه سازی تأثیر طول روزنه سمت چپ بر امپدانس ورودی و گین آنتن
- شکل ۱۵-۶ نتایج شبیه سازی تأثیر طول روزنه سمت راست بر روی گین و $VSWR$ آنتن
- شکل ۱۶-۶ نتایج شبیه سازی تأثیر فاصله بین روزنه‌ها بر مشخصات آنتن با ساختار ۵
- شکل ۱۷-۶ امپدانس ورودی آنتن روی نمودار اسپیت
- شکل ۱۸-۶ نمودار تشعشع آنتن ساختار ۵ : (الف) 5 GHz ، (ب) 3 GHz ، (ج) 4 GHz
- شکل ۱۹-۶ نمای سه بعدی، بالایی و جانبی آنتن مایکرواستریپ ساختار ۶
- شکل ۲۰-۶ نتایج شبیه سازی اثر فاصله بین خطوط تغذیه L_۵ بر $VSWR$ آنتن
- شکل ۲۱-۶ نتایج شبیه سازی تأثیر طول خط تغذیه سمت راست بر $VSWR$
- شکل ۲۲-۶ نتایج شبیه سازی طول خط تغذیه سمت راست $L_۳$ بر $VSWR$ آنتن
- شکل ۲۳-۶ نتایج شبیه سازی گین آنتن در زاویه صفر درجه
- شکل ۲۴-۶ نمودار تشعشعی آنتن ساختار ۶ در چند فرکانس: (الف) 7 GHz ، (ب) 9 GHz ، (ج) 10 GHz ، (د) 12 GHz
- شکل ۲۵-۶ نتایج شبیه سازی نمودار اسپیت امپدانس ورودی ساختار ۶
- شکل ۲۶-۶ نتایج شبیه سازی نمودار تشعشع ۳ بعدی آنتن در فرکانس‌های (الف) 7 GHz ، (ب) 10 GHz

فصل اول

مقدمه

مقدمه

آنتن‌های مایکرواستریپ اولین بار در سال ۱۹۵۳ پیشنهاد شد. اما عملاً در سال ۱۹۷۴ پس از گذشت بیست سال مورد استفاده قرار گرفت. اولین کتابی که در رابطه با این نوع آنتن‌ها منتشر شد کتاب "آنتن‌های مایکرواستریپ".

است که در سال ۱۹۸۰ توسط انتشارات Artech House به چاپ رسید. پس از آن، کتاب‌های متعددی در این زمینه بچاپ رسید که تقریباً همه آنها فصلی به آنتن‌های مایکرواستریپ پهن‌باند اختصاص داده‌اند.

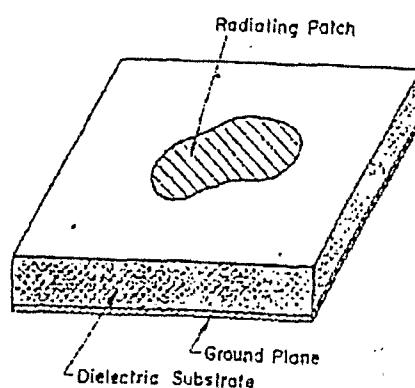
آن‌تنهای مایکرواستریپ در حالت کلی دارای مزایای زیادی نظیر وزن کم، سادگی ساخت و روش‌های متنوع تغذیه نسبت به سایر آنتن‌های مرسوم می‌باشند. این در حالی است که آنتن‌های مایکرواستریپ دارای معایب ذاتی مانند پهنای باند باریک و بهره کم هستند. برای حل مساله افزایش پهنای باند و بهره تکنیک‌های مختلفی بکار رفته است که در بخش زیر اشاره می‌شود.

- (۱) استفاده از ساختارهای چند لایه
- (۲) استفاده از پج‌های اضافی در کنار پج اصلی
- (۳) استفاده از شبکه‌های تطبیق امپدانس جهت افزایش پهنای باند
- (۴) استفاده از عایقهای با ثابت دی‌الکتریک پایین
- (۵) استفاده از لایه‌های دی‌الکتریک
- (۶) ایجاد شکاف بر روی پج‌ها

۱-۱ معرفی آنتن‌های مایکرواستریپ

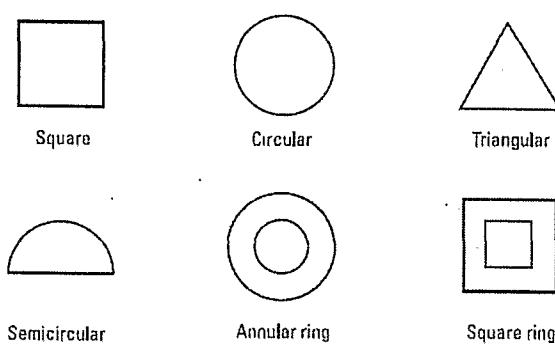
ساختار کلی آنتن‌های مایکرواستریپ در شکل ۱-۲ نشان داده شده است که با قرار دادن پج (صفحه فلزی) بر روی یک لایه دی‌الکتریک تشکیل می‌شوند. ثابت دی‌الکتریک استفاده شده در این آنتن‌ها معمولاً کوچکتر از ۱۰ است. برای مقادیر کم ثابت دی‌الکتریک میدانهای نشتی زیاد شده و به همین دلیل تشعشع آنتن و پهنای باند آن افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که با کاهش ثابت دی‌الکتریک ساخت آنتن با مشکلاتی همراه است. بعنوان مثال برای ساختن آنتن با لایه دی‌الکتریک هوا که کمترین مقدار را دارد چندین میله نگهداری پج لازم است.

سمت دیگر لایه عایق صفحه زمین قرار دارد. بخش‌های فلزی آنتن مایکرواستریپ معمولاً از طلا یا مس ساخته می‌شوند.



شکل ۱-۱ ساختار آنتن مایکرواستریپ

آنتن‌های مایکرواستریپ با انواع مختلفی از شکل پچ بکار رفته‌اند. بطور نمونه چندین پچ در شکل ۲-۲ نشان داده شده است که هر کدام دارای خصوصیات تشعشع خاص خود می‌باشد.



شکل ۱-۲ شکل‌های مختلف پچ آنتن مایکرواستریپ